

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年12月5日(2019.12.5)

【公開番号】特開2019-54130(P2019-54130A)

【公開日】平成31年4月4日(2019.4.4)

【年通号数】公開・登録公報2019-013

【出願番号】特願2017-177786(P2017-177786)

【国際特許分類】

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/02 P

H 05 K 3/46 Z

H 05 K 3/46 N

【手続補正書】

【提出日】令和1年10月21日(2019.10.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0129

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0129】

図3Dの実線および仮想線で示すように、次いで、クロム(熱膨張係数6.8(ppm/K))からなり、厚みTaが30nmである密着層8をスパッタリング法により形成し(第4工程)、続いて、銅(熱膨張係数16.8(ppm/K))からなり、厚みTbが120nmである本体層9をスパッタリング法により形成した(第5工程)。これにより、平坦部21および凹部22を有するシールド層5を形成した。なお、シールド層5は、まだ、シールド開口部27を有しておらず、つまり、密着層8を、中間絶縁層4の上面全面と、シールド層5の内側面10と、中間開口部15から露出する延出部16の上面とに、連続して形成し、また、本体層9を、密着層8の上面全面に形成した。